

Power MOSFET

F20S60C3

600V 20A

特長

- 低オン抵抗
- 高速スイッチング
- 面実装タイプ

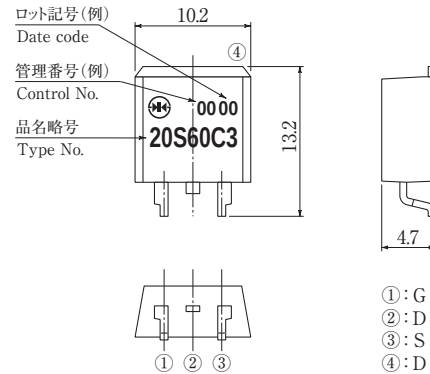
Feature

- Low R_{ON}
- Fast Switching
- SMD Package

■外観図 OUTLINE

Package : STO-220

Unit:mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

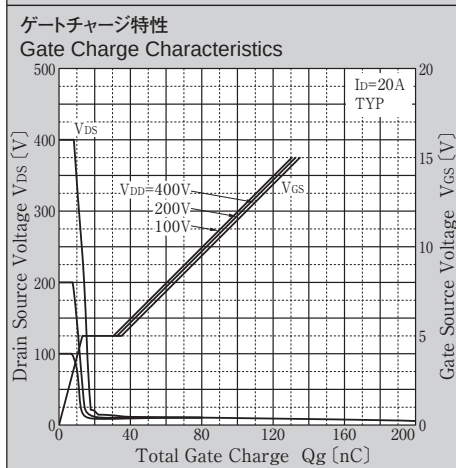
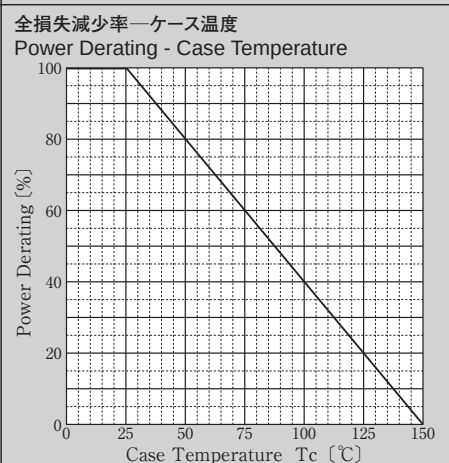
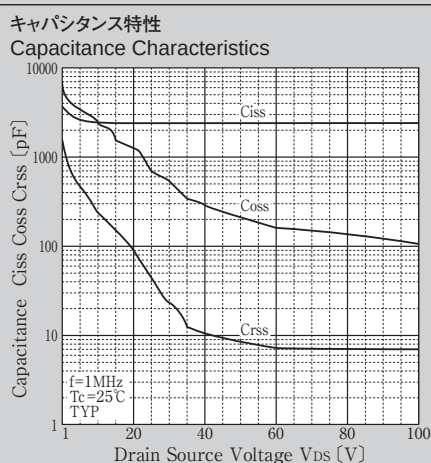
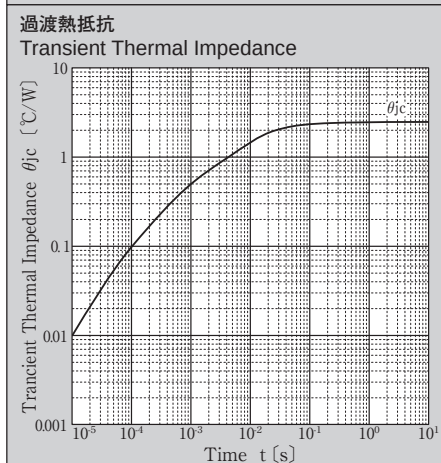
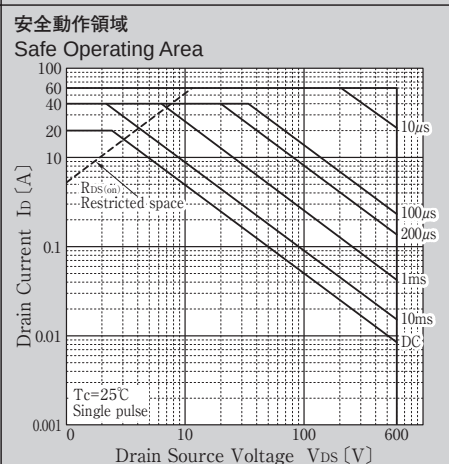
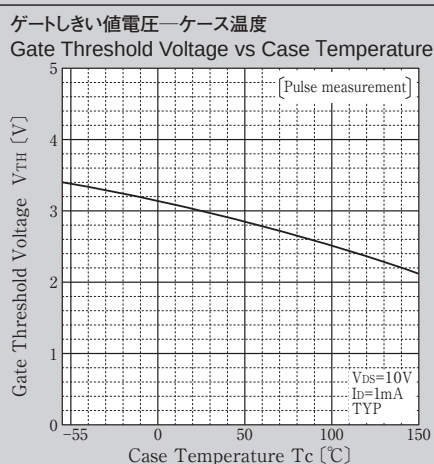
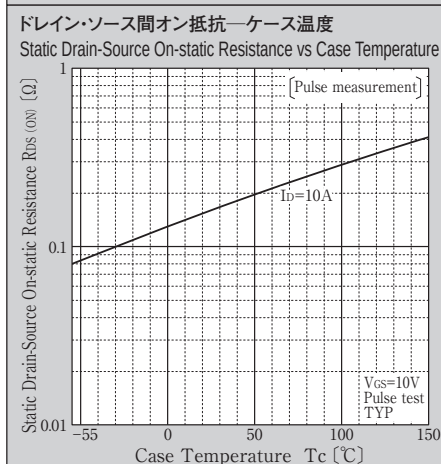
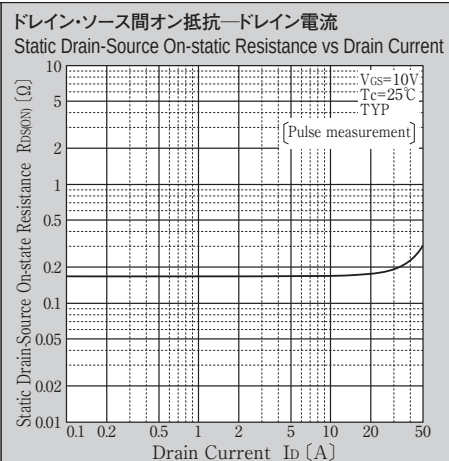
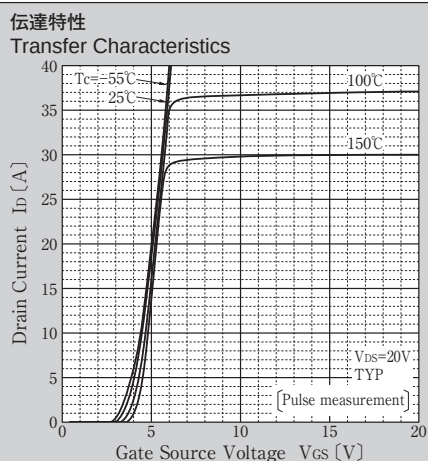
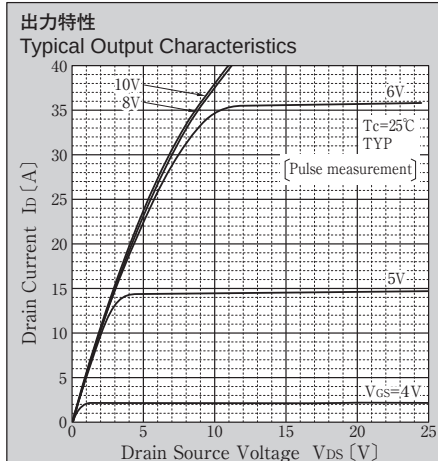
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-55~150	$^\circ\text{C}$
チャネル温度 Channel Temperature	T_{ch}		150	
ドレイン・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V_{DSS}		600	
ゲート・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V_{GSS}		± 30	V
ドレイン電流 (直流) Continuous Drain Current (DC)	I_D		20	A
ドレイン電流 (ピーク) Continuous Drain Current (Peak)	I_{DP}	パルス幅 $10\mu\text{s}$, duty=1/100 Pulse width $10\mu\text{s}$, duty=1/100	60	
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I_S		20	
全損失 Total Power Dissipation	P_T		50	W

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
ドレイン・ソース間降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	600	—	—	V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS} = 600\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	—	—	25	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$	—	—	± 0.1	
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g_{fs}	$I_D = 10\text{A}$, $V_{DS} = 10\text{V}$	8.7	17.5	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	$R_{(DS)ON}$	$I_D = 10\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$	—	0.16	0.19	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V_{TH}	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{DS} = 10\text{V}$	2.1	3.0	3.9	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V_{SD}	$I_S = 10\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	—	—	1.5	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	2.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 20\text{A}$, $V_{DD} = 400\text{V}$	—	87	—	nC
入力容量 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS} = 25\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	—	2400	—	pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		—	50	—	
出力容量 Output Capacitance	C_{oss}		—	780	—	
ターンオン遅延時間 Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$I_D = 10\text{A}$, $V_{DD} = 150\text{V}$, $R_L = 15\Omega$ $V_{GS(+)} = 10\text{V}$, $V_{GS(-)} = 0\text{V}$	—	32	—	ns
上昇時間 Rise time	t_r		—	60	—	
ターンオフ遅延時間 Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		—	355	—	
下降時間 Fall time	t_f		—	60	—	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.